



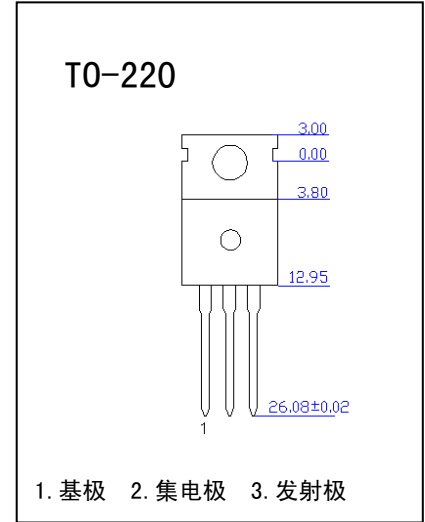
TO-220 Plastic-Encapsulate Transistors

主要用途 TIP42C

音频功率放大

极限值 (TA=25°C)

参数说明		参数符号	数值	单位
集电极—基极电压		V_{CB0}	-100	V
集电极—发射极电压		V_{CE0}	-100	V
发射极—基极电压		V_{EB0}	-5	V
集电极电流		I_C	6	I_C
集电极耗散功率	P_C	P_C	2	W
	P_C	P_C	65	W
结温		T_J	150	T_J
贮存温度		T_{STG}	-55-150	T_{STG}



电参数 (TA=25°C)

参数说明	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极—发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=-60V, I_E=0$			-700	μA
集电极—发射极饱和电流	I_{CES}	$V_{CE}=-100V, V_{EB}=0$			-400	μA
基极—发射极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=-5V, I_C=0$			-1	mA
集电极—发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=-30mA, I_B=0$	-100			V
发射极—基极击穿电压	BV_{EB0}	$I_E=-100\mu A, I_C=0$	-5			V
集电极—基极击穿电压	BV_{CB0}	$I_C=-100\mu A, I_E=0$	-100			V
集电极—发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-6A, I_B=-600mA$			-1.5	V
基极—发射极导通电压	$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=-4V, I_C=-6A$			-2.0	V
直流电流增益	HFE1	$V_{CE}=-4V, I_C=-0.3A$	30			
	HFE2	$V_{CE}=-4V, I_C=-3A$	15		75	
特征频率	f_T	$V_{CE}=-10V, I_C=-0.5A$	3			MHz